

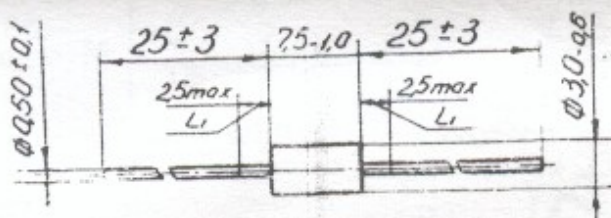


Диоды 2Д503А, 2Д503Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиальные импульсные диоды 2Д503А, 2Д503Б в стеклянном корпусе предназначены для применения в импульсных быстродействующих схемах в качестве быстродействующих переключателей, в схемах вычислительной техники наносекундного диапазона.

Климатическое исполнение УХЛ.



Размеры выводов в пределах размера L_1 не регламентированы.

Масса не более 0,3 г.

Основные электрические параметры

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма, не более		Температура, °С
	2Д503А	2Д503Б	
Постоянный обратный ток диода (при постоянном обратном напряжении диода 30 В), мкА	4	4	25±10
	50	50	125±5
	4	4	-60±3
Постоянное прямое напряжение диода (при постоянном прямом токе диода 10 мА), В	1	1,2	25±10
	1,4	1,6	125±5
	1,4	1,6	-60±3
Заряд восстановления диода (при импульсном прямом токе 10 мА и импульсном обратном напряжении 10 В), нКл	120	120	25±5
	5	2,5	25±10
Общая емкость диода (при постоянном обратном напряжении диода 0-0,05 В), пФ	2,5	3,5	25±5

Содержание драгоценных металлов в одном диоде:

золото 0,0000266 г

Сведения о приемке

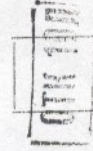
Диоды 2Д503А, 2Д503Б соответствуют техническим условиям
3.362.045 ТУ.

Приняты по извещению №

614

от

13.09.91.



1922-1990